Бескислородные керамические материалы

Лекция

бескислородные соединения

«фазы внедрения»: типичная металлическая решетка –

кубическая (гранецентрированная или объемо-центрированная)

или гексагональная, атомы неметалла находятся в пустотах

два структурных

между металлическими атомами.

металлоподобные свойства

карбиды

нитриды MeN

бориды MeB_n

СИЛИЦИДЫ

MeSi

MeC

слоистые и цепочечные структуры (имеют такие же некоторые нитриды и SiC)

Отличительная особенность неоксидных соединений значительно большая по сравнению с оксидами доля ковалентности и прочность химических связей.

обладают высокими температурами плавления, прочностью химических связей, теплопроводностью, электрической проводимостью или диэлектрическими свойствами, химичес кой стойкостью

конструкционная керамика – детали двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных двигателей, режущих инструментов, керамических подшипников. Керамику с электрической проводимостью используют для изготовления нагревательных элементов

Термообработка бескислородных соединений

Диффузионные процессы в кристаллах неоксидных соединений по сравнению с оксидами происходят очень медленно, благодаря высокой доле ковалентности и прочности химической связи.

Это исключает возможность спекания таких соединений, как SiC, Si_3N_4 , A1N по твердофазному механизму

Соединения с меньшей долей ковалентности химической связи, такие как *TiC, NbC, ZrB*, и ряд других, можно спекать и по твердофазному механизму

используют реакционное спекание или специальные добавки, которые образуют жидкую фазу и обеспечивают жидкофазное спекание

недостаток неоксидных соединений: их способность к окислению кислородом воздуха

Для предохранения от окисления на поверхности изделий часто специально создают защитное оксидное покрытие

Структура карбидов

Общая формула

Структурные типы

с изолированными атомами бидов:

углерода

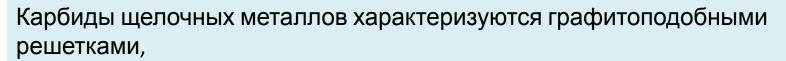
с изолированными парами атомов

углерода

с цепями из атомов

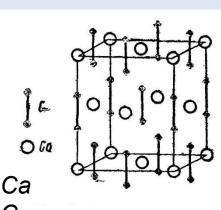
углерода

с сетками из атомов



карбиды щелочноземельных металлов: склонность к образованию сложных анионов из атомов углерода уменьшается, для них характерны карбидные фазы MeC_2 со структурами из изолированных пар атомов углерода

Карбиды CaC_2 , SrC_2 и BaC_2 кристаллизуются в тетрагональной ячейке типа CaC Карбид MgC_2 кристаллизуется в тетрагональной ячейке типа ThC_2



ThC

2

Структура карбидов

Лантаноиды и близкие к ним по положению в периодической системе элементов скандий и иттрий образуют карбидные фазы, соответствующие составам:

Me₃

кубическая структура типа

 Fe_4N

МеС г.ц.к решетка типа

n.ц.к решетка NaCl

 Me₂C
 о.ц.к. структура типа

 2
 Pu₂C₂

Карбиды переходных металлов образуют в основном фазы внедрения или близкие к ним фазы с изолированными атомами углерода и со структурными цепями из атомов углерода

Дикарбиды образуют иттрий и все лантаноиды. Они кристаллизуются в о.ц. тетрагональной структуре типа *CaC*₃

правило Хэгга: Rc/Rмe не более 0.59

MeC

2

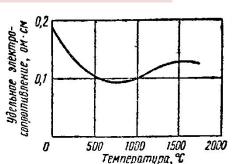
Свойства карбидов

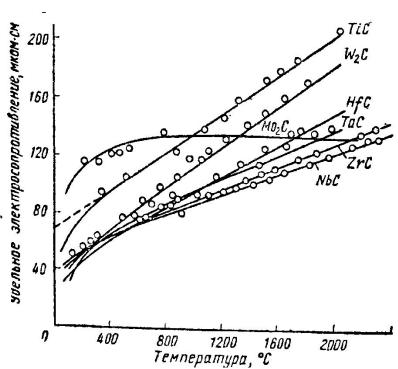
Карбиды щелочных металлов малоустойчивы и разлагаются при температурах порядка 800 °C

Карбиды металлов IV, V и VI группы периодической системы Менделеева отличаются высокой температурой плавления или разложения. Температуры кипения карбидов : например, 2537 °C для Be_2C и 6000 °C для WC при атмосферном давлении.

Величины коэффициентов термического расширения карбидов переходных металлов близки к их значениям для самих металлов и уменьшаются с ростом порядкового номера элемента в группе.

карбиды переходных металлов обладают металлической проводимостью, карбиды неметаллов обладают полупроводниковыми свойствами





Химическая стойкость карбидов

две группы:

Разлагаемые водой карбиды I и II групп периодической системы, карбиды алюминия, редкоземельных металлов и актиноидов

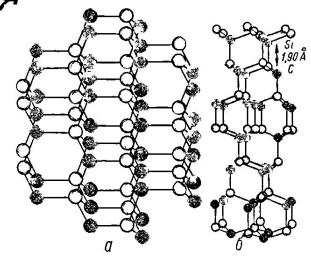
неразлагаемы
е карбиды кремния,
бора
и переходных устойчивы к воздействию минеральных металлов кислот, их смесей и растворов щелочей

Карбид	Продукт разложения
Карбиды щелочных и	ацетилен
щелочноземельных	
металлов	
Be ₂ C, Al ₄ C ₃	метан
MgC,	метилацетилен
Карбиды редкоземельных	Метан и H ₂
металлов Ме ₃ С _{1-х}	2
Карбиды редкоземельных	Ацетилен и H ₂
металлов Мезс, и МеС,	-

Карбид кремния

 α -SiC — это высокотемпературная модификация с многослойной цепочечной структурой, образует большое число структурных типов, имеющих гексагональную и ромбоэдрическую решетки β -SiC имеет кубическую структуру типа сфалерита и при температуре выше 2100°C переходит в α -форму

При температуре 2050 °C в вакууме α -SiC частично разлагается с выделением графита, а при 2150 °C полностью разлагается. При температуре выше 2700 °C карбид кремния возгоняется



β-SiC	a-SiC
○ – атомы Si	, ● – атомы
С	

01 01 17 10 1 07 1	
Плотность истинная, г/см ³	3.21
Твердость по шкале Мооса	9.2 – 9.5
Микротвердость, МПа	300 – 400
Предел прочности, МПа	
при сжатии	2250
перпендикулярно оси	
при изгибе	155
Теплопроводность при	16 – 20
200–1400 °С, Вт/(м·К)	
Коэффициент линейного	5.2·10 ⁻⁶
расширения при 20-1000°C	

Методы получения карбида кремния

Метод Ачессона

идет в две стадии: восстановление кремнезема углем до металлического кремния и взаимодействие паров кремния с углем или с окисью углерода

кварцевый песок, содержащий не менее $98.5\%~SiO_2$ и минимальное количество примесей в виде $A1_2O_3$, CaO_3 , MgO и Fe_2O_3

Углеродсодержащее сырье – малозольный кокс, антрацит и нефтяной кокс. В шихту добавляют древесные опилки (для увеличения газопроницаемости) и хлористый натрий (рафинирование хлорированием примесей)

электрические печи Пропускают ток через угольные электроды и сердечник. Сердечник набирают из кусков кокса. Температура 2500–2600 °C, продолжительность процесса около 40 часов два вида карбида кремния

– зеленый и черный

Способы получения монокристаллов SiC

- 1) кристаллизация из жидкого карбида кремния (требует создания установки, в которой можно достигнуть температуры 2000° С при давлении до сотен тысяч атмосфер);
- 2) кристаллизация из растворов;
- 3) сублимация;
- 4) термическое разложение;
- 5) термическое восстановление

Метод Лели: испарение поликристаллического карбида кремния при температуре 2500–2650 °C и последующая конденсация паров на случайных зародышах

Недостаток метода Лели - большое количество зародышей - избыток мелких кристаллов и образование друз

сэндвич-

метод малых промежутков источником и затравкой служат кристаллы полупроводникового материала

Использование

метод физического транспорта паров Physical Vapour Transport – PVT

конденсация пересыщенного пара, возникающего при сублимации синтезированного *SiC* на монокристаллическую затравку

- 1 затравка,
- 2 поликристаллический карбид кремния,
- 3 графитовый тигель,
- 4 теплоизоляция



Применение карбида кремния

материал для производства электронагревательных сопротивлений (термисторы)

Изготовление керамических варисторов, т. е. материалов, изменяющих свое сопротивление под влиянием напряжения

для ограничения силы тока при возрастании напряжения: в системах, предназначенных для предохранения высоковольтных линий электропередач от атмосферных перенапряжений, для защиты от перенапряжения приборов и элементов схем, для искрогашения на контактах, в импульсной технике в цепях питания реле как умножители частот, для стабилизации токов и напряжений.

Малопористый SiC с относительной плотностью 0.91–0.98 применяют в качестве конструкционного материала

Карбид бора В_₄С: свойства

ромбоэдрическая кристаллическая решетка

обладает высокой твердостью, уступающей только алмазу

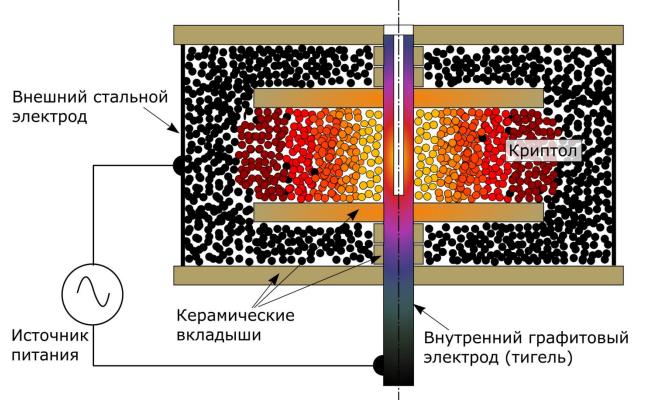
применяется для шлифования и полирования твердых материалов; заточки и доводки резцовых пластин из твердых сплавов; в качестве режущих элементов

обладает большим поперечным сечением захвата нейтронов и используется в качестве материала регулирующих стержней для ядерных реакторов

может применяться как контактирующий с плазмой материал в современных термоядерных установках

синтез из элементов осу нагреванием смеси бора температуре выше 1600 экономически малоэфф

Восстановление борного наиболее распространенометод



шихта из борной кислот

Борный ангидрид расплавляется и образуется губка хорошо перемешанная с сажей

шихта расположена в трех зонах: керновые, бескерновые, печи типа Таммана, электродуговые печи

- 1) центральной высокотемпературной, где температура выше 1850° С (в этой зоне завершается процесс восстановления борного ангидрида е образованием карбида);
- 2) промежуточной, заполненной смесью из недовосстановленного борного ангидрида, карбида бора и неизрасходованного угля;
- 3) наружной, заполненной в основном исходной шихтой

Методы получения В_₄С

Магниетермически

$$2B_{2}^{N}O_{3} + 6Mg + C = B_{4}C + 6MgO$$

в среде водорода при температуре 1800° С

продукты реакции содержат окись магния, их промывают соляной кислотой и остаток прогревают в вакууме при температуре 1800° С для удаления летучих примесей

Восстанавление хлорида бора водородом в присутствии угля по реакции $4BCl_{_{3}} + 6H_{_{2}} + C = B_{_{4}}C + 12HCl$

нагревают при температуре 600° С шихту из борного ангидрида и избытка сажи в токе хлора. При этом образуется смесь BCI_3 и CO. Эту смесь с водородом пропускают над накаленной вольфрамовой нитью, на которой осаждается слой карбида

Монокристаллы карбида бора получают осаждением из газовой фазы

 $4BCI_3 + CCI_4 + 8H_2 = B_4C +$ 1550—1650°С, скорости подачи смеси BCI_3 и CCI_4 г/мин при избытке водорода в течение 4–5 ч

плотноспеченные

изделияяют

и давлении 10-25 МПа

Активиронанного стоенкания: введение в состав оксидов, металлов и их сплавов и тугоплавких соединений горячее прессование 1750 – 2100 °C

Нитриды

 $M_n N_m$

По типу химической

Ионные: нитриды щелочных и щелочноземельных металлов (а также элементов

подгрупп меди и цинка) атомы которых имеют внешние не^{s-электроны} взаимодействуют с кислородом воздуха. При температурах плавления начинают разлагаться на элементы.

Ковалентные нитриды образуются при соединении с азотом металлов и неметаллов, атомы которых имеют внешние р-электроны (B, Al, Si, Ga, Ge)

обладают высокой стойкостью против окисления, против действия расплавленных металлов, горячих кислот, различных агрессивных газов начинают разлагаться на элементы при температурах 1000–1200 °C

Металлоподобные нитриды образуются переходными металлами, атомы которых имеют незавершенные электронные d- или f- оболочки. Эти нитриды являются структурами внедрения атомов азота в кристаллические решетки переходных металлов.

обладают высокой химической стойкостью, особенно против действия холодных и кипящих кислот, многих расплавленных металлов, а также против окисления на воздухе. Быстро разлагаются при сплавлении со щелочами и солями щелочных металлов.

Нитрид бора



три модификации нитрида бора: α -BN (гексагональный), структура аналогична слоистой структуре графита β -BN (кубический) и γ -BN (гексагональный плотноупакованный).

диэлектрик с шириной запрещенной зоны около 4 эВ α -BN плавится при 3000 °C (под давлением азота)! Плотность 2.29 г/см³

Получение

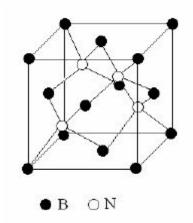
восстановление борсодержащих соединений углеродом в присутствии азота

$$B_2O_3 + 3C + N_2 = 2BN + 3CO$$

Можно получить азотированием оксида бора в среде аммиака
И в газовой фазе по реакции между треххлористым бором и аммиаком

применяются для нужд атомной энергетики, электротехники, производства полупроводников, диэлектриков

Нитрид бора



β-BN (боразон) кристаллизуется в структуре цинковой обманки ZnS (кубическая структура)

Плотность 3.45 г/см³, твердость 10. Является хорошим диэлектриком с шириной запрещенной зоны 10 эВ. Устойчив к окислению до 1900 – 2000 °C

Структура кубического нитрида бора *β-вN* алмаз при температуре около 800 °C начинает окисляться!

получают из гексагонального нитрида бора с добавками при высоком давлении (5 – 10 ГПа) и 1600 – 2000 °C

благодаря высокой твердости широко применяют как абразивный материал

Нитрид алюминия

Кристаллизуется в гексагональной решетке типа вюрцита, кристаллы бесцветные

A1N не имеет модификаций

Плотность (рентгеновская) 3.27 г/см³.

При 1900 – 2000 °C *A1N* разлагается.

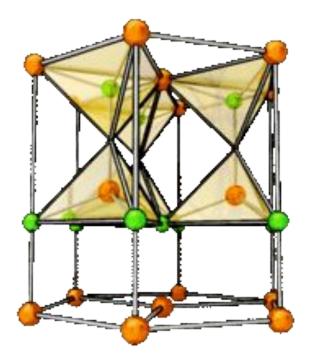
Температура плавления (под давлением азота) 2400°C. Твердость от 5 до 9.

Является диэлектриком с шириной запрещенной зоны 3.8 – 5 эВ.

не действуют расплавленный алюминий (до 2000°С), галлий (до 1300°С), борный ангидрид (до 1400°С). AIN устойчив в смеси расплавленного криолита и алюминия в течение 65 часов при 1200°С.

A1N медленно растворяется в горячих минеральных кислотах.

Горячие концентрированные растворы щелочей растворяют *A1N* с выделением аммиака.



Свойства нитрида

отличительная особенность высокая теплопроводность и термостойкость

ПЛНОМИНИЯалюминия может устойчиво применяться в инертной среде – до 1800 °C, в вакууме – до 1600 °C, на воздухе – до 1300 – 1400 °

тлотность (ренттеновская), г/см ³	C.
твердость по шкале Мооса	9
Предел прочности при	
изгибе, кГ/см² при темпера	
туре	
25°C	2700
1400°C	1270
Теплопроводность, Вт/(м²⋅с)	160–260
25°C	
Коэффициент линейного	4.5
расширения α·10 ⁻⁶ при	
100-500 °C	
Удельное объемное	10 ¹³
сопротивление в Ом-см при	
температуре 20 °C	
при 1200° С	9·10 ³
Диэлектрическая	8.5
постоянная при 20° С	

Получение нитрида алюминия

прямое азотирование порошка алюминия азотом при умеренных температурах (800 – 1200 °C)

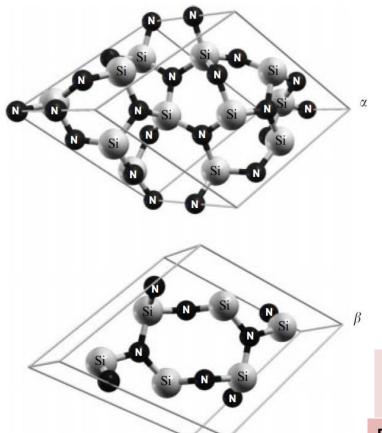
восстановление тонкодисперсного оксида алюминия и одновременное азотирование

Изделия из нитрида алюминия получают в основном тремя методами:

- а) спеканием отпрессованных заготовок при давлении 30 МПа в среде азота при температуре до 2000°C;
- б) реакционным спеканием сформированных изделий из смеси *A1N* и порошка алюминия в азоте или аммиаке, однако этот метод не позволяет изготовлять плотные изделия;
- в) горячим прессованием порошка *A1N*, подготовленного тем или иным способом. Этим методом можно получать керамику с относительной плотностью 99.5% при 1700°С, давлении прессовании 20 МПа и времени выдержки 15 20 мин.

Нитрид кремния

две модификации $Si_{_3}N_{_4} - \alpha$ и β . Обе кристаллизуются в гексагональной системе, построены из тетраэдров



Плотность (рентгеновская) 3.184 г/см³. Температура разложения 1900°С. Коэффициент линейного расширения 2.75 в интервале 20–1000°С. Удельное сопротивление при 20°С составляет 10¹³ – 10¹⁴ Ом·см. отличается исключительно высокой химической устойчивостью: по отношению к кислотам, парам воды, большинству расплавленных металлов (*Al, Pb, Zn, Sn* и др.), к окислению в среде кислорода при умеренных температурах.

Получают α - Si_3N_4 прямым

восстановлением оксида кремния углем в среде азота в интервале 1250–1300°C

Изделия изготовляют при температуре около 1600°C

Плотные изделия получают горячим прессованием

Бориды

 Me_xB_y

образуют сложные цепочечные слоистые и каркасные структуры

имеют весьма высокую температуру плавления или разложения: TiB_2 – 2980 °C, ZrB_2 –3040, TaB_2 – 3000; HfB_2 – 3250°C

Обладают высокой твердостью и хорошей термической стойкостью Большинство боридов устойчиво против действия минеральных кислот, но разлагается в расплавленных щелочах. Однако бориды очень чувствительны к окислению даже при умеренных температурах (800–1200°C).

используются при изготовлении электродов, режущего инструмента, износостойких деталей, в качестве наплавки для упрочнения изделий

Для увеличения сопротивления окислению боридов циркония и гафния в порошковые композиции вводят добавки, такие как карбид кремния, оксид и борид лантана, силициды циркония, молибдена, тантала и др

добавки наноразмерных порошков способствуют активации спекания керамики, понижению температуры спекания, улучшают механические свойства спеченного материала

Получение диборида циркония

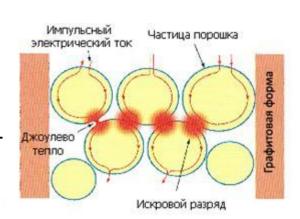
Из порошков двуокиси циркония, борного ангидрида и сажи при температуре 2000°С и времени выдержки 60–240 минут в среде водорода или конвертированного газа

Борный ангидрид перед использованием необходимо размалывать в шаровой мельнице в течение 15 часов

Нагрев шихты из смеси двуокиси циркония и высокодисперсных карбида бора и углеродного материала при температуре 1600–1700°С в течение 25–30 минут.

примесь углерода, образующаяся в процессе предварительной обработки и синтеза порошка *ZrB*₂, отрицательно влияет на процессы спекания Плотные изделия на основе боридов

Плотные изделия на основе боридов получают горячим прессованием и методом искрового плазменного спекания с применением спекающих добавок (оксида алюминия и оксида иттрия). В искровом плазменном спекании используется импульсный постоянный ток с высоким значением силы тока для быстрого и равномерног распределения энергии искровой плазмы между частицами.





Силициды

соединения кремния с металлами в основном IV – VI групп Периодической системы элементов Д. И. Менделеева образуют сложные цепочечные слоистые и каркасные структуры

Обладают большой теплопроводностью и хорошей термостойкостью. Как правило, они стойки к окислению до 1500 – 1700 °C и к минеральным кислотам.

Температуры плавления или разложения в °C: Ti_5Si_3 – 2120; ZrSi – 2045; $TaSi_2$ – 2400; HfSi – 2100; $MoSi_2$ – 2030

Изделия из силицидов можно получить прессованием и последующим спеканием, горячим литьем, а также литьем пластифицированных шликеров

Дисилициды хрома ($CrSi_2$) и железа ($FeSi_2$) являются узкозонными полупроводниками перспективными в создании фотодетекторов, чувствительных в инфракрасной области спектра. Силициды применяются для получения эмиттерных и базовых контактов в биполярных транзисторах

Дисилицид молибдена MoSi₂

 $MoSi_2$ имеет слоистую структуру, состоящую из двух слоев атомов кремния и одного слоя атома молибдена

Нерастворим в минеральных кислотах, даже в плавиковой кислоте и царской водке, но растворим в смеси HF и HNO_3 с выделением паров азота. Водные растворы щелочей на него не действуют, но расплавы щелочей разлагают.

Изделия из $MoSi_2$ при нормальных и высоких температурах имеют высокую прочность, например при 1000°С около 500 МПа, при 1200°С – около 400 МПа

Коэффициент линейного расширения при 200 – 1500°C равен 9.2·10⁻6

MoSi, обладает электронной проводимостью дырочного типа

нагревательные элементы сопротивления до 1700°C

Методы получения порошков некоторых бескислородных соединений по Гузману

Соединение	Метод	Исходные вещества	Условия получения
Карбид кремния (SiC)	ĺ	Кремний, сажа	Ступенчатый нагрев при 1150–1200 °С и 1250–1350 ° С смеси расчетного состава
	II	Кварцевый	Нагрев в электрической печи с добавкой в шихту
		песок, нефтяной кокс	древесных опилок и поваренной соли по методу Ачессона
Карбиды циркония, гафния, ниобия, тантала (ZrC, HfC, NbC, Ta ₂ C)	l	Порошки	Нагрев при 1600–1900 °C брикетов из смеси
		металлов, сажа	расчетного состава
	II	Оксиды	Нагрев при 1700–1950 °C и циклическом
		металлов, сажа	виброперемешивании или в среде Н ₂ , вакууме
	III	Хлориды ме	Нагрев парогазовой смеси до 350 –400°C в
		таллов, метан,	графитовой трубке или синтез при 1250–1450°C
		водород	

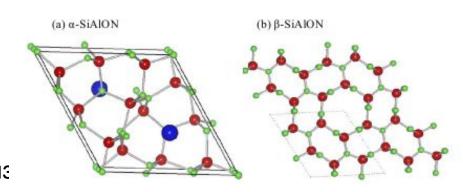
Нитрид алюминия (AIN)	I	Порошок алю миния, азот или аммиак	Нагрев в токе азота или аммиака при 1000–1300°C
	II		Нагрев смеси расчетного состава в токе азота при 1500–1800 °C
Нитрид бора (BN)	l	Бор, азот	Нагрев порошка аморфного бора в токе азота при 2000 °C
	II	Борный ангидрид (кислота), сажа, азот	Нагрев шихты расчетного состава при 1500–1700 °C
	III	Хлорид бора и аммиак или боразин и азот	Нагрев при 1000–1500°C
	l	Порошок крем ния, азот или аммиак	Азотирование кремния по двухступенчатому режиму: при 1300–1350°C и 1450–1550°C
	II	•	Нагрев шихты расчетного состава при 1250–1300°С в токе азота
	Ш	Хлорид кремния, азот, водород (или аммиак)	Нагрев при 1000–1560°C
Дисилицид молибдена (MoSi ₂)	l	Молибден, кремний (избыток 5%)	Нагрев расчетной смеси при 1350–1400°C

Синтез и свойства сиалонов

Сиалон был получен при изучении системы Si_3N_4 –AIN– AI_2O_3 – SiO_2

В основе структуры сиалона лежит Si_3N_4 , в котором Si^{4+} замещен на Al^{3+} , а N^{3-} на O^{2-}

физические и механические свойства близ к $Si_3N_{4,}$ а химические свойства – к оксиду алюминия



В системе выделяют несколько видов сиалонов:

гексагональный β-сиалон, аналогичный β-Si₃N₄, имеющий состав Si_{6-x}Al_xO_xN_{8-x}, где 0<x<4.2; х означает количество связей Si-N, замещенных связями Al-O. Гексагональный α-Si₄ION аналогичный α-Si₅N₄ образует фазы

$$M_x^v Si_{12-(m+n)} Al_{m+n} O_n N_{16-n}$$
 где x=m/v, x≤2, v – валентность металла М - Li, Na, Ca, Mg, Y или РЗЭ.

Различают до 10 типов сиалонов, обладающих разной кристаллической структурой (существуют сиалоны со структурой нитрида кремния, оксинитрида кремния, нитрида алюминия и муллита).

Наиболее широко используют β-сиалоны

Получение сиалоновых материалов

- реакционное спекание,
- карботермическое азотирование алюмосиликатов,
- самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС),
- металлотермический способ,
- синтез в атмосфере аммиака или паров кремнийорганических соединений

Порошок α-сиалона получают из экзотермической смеси: 30–70 мас.% горючей составляющей порошка кремния и/или алюминия и 30–70 мас.% негорючей составляющей, в качестве которой используют, по меньшей мере, одно вещество из ряда: *Na, Li, Mg, Ca*, оксид *Y* или *Nd*. Локальное воспламенение и термообработку осуществляют в режиме горения при температуре 1860 – 2500 °C и давлении 4–500 МПа.

Получение однофазного β-сиалона достигается спеканием в две стадии смеси порошков нитрида кремния, нитрида алюминия и оксида алюминия в среде азота при 1750 – 1850 °C на первой стадии, а затем при 1100 – 1200 °C и давлении 3.0–5.0 ГПа на второй стадии.

Свойства сиалона

керамика на основе β-сиалона

плотность 3–3.1 г/см3; твердость по Виккерсу 13–15ГПа; модуль Юнга 200–280 ГПа; ТКЛР в интервале 20 – 1200°С (2.4–3.2)·10⁻⁶ К⁻¹. имеют более низкую теплопроводность, чем керамика на основе Si_3N_4

используют в двигателестроении, производстве режущих инструментов, подшипников, насадок на горелки Керамика на основе α -сиалона

плотность 3.2 г/см3 при 20 и 1200°C прочность при изгибе 700 и 500 МПа соответственно

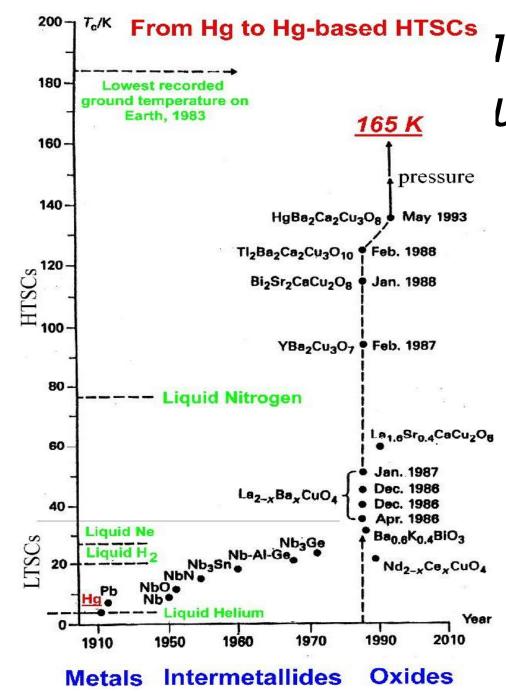
высокотемпературная печная фурнитура, чехлы для термопар, горелочные камни, в качестве связки для карбида кремния и т.д., в качестве зубных сверел, металлорежущего инструмента и пар трения.

SiCAION

Из SiC, оксикарбида алюминия $A1_2OC$ и A1N, имеющих гексагональную вюрцитовую структуру, получен твердый раствор, названный SiCAION

Керамика, полученная в среде азота без применения горячего прессования при температурах, не превышающих 2100°C, обладает прочностью при изгибе 300 МПа. После горячего прессования при 1800 – 2000°C,

- 35 МПа прочность при изгибе составляет 600 МПа, твердость 25 ГПа.
- Керамика с небольшими добавками алюминия, бора и углерода сохраняет высокие прочностные свойства до 1600 °C.
- Керамика на основе *SiCALON* перспективна для использования в машиностроении



тературная цая керамика

1986 и 1987 г *YBa2Cu3O7-δ* с Tc ≈ 90 К при δ = 0

> 1996 г *La2-xMxCuO4* с *M* = Sr, Ba, Ca,

Тс составляет около 40 К «азотный барьер» пройден в плоскостях *CuO2* формируется

сверхпроводящий конденсат

0.1 < x < 0.3

2001 *MgB2*

промежуточное положение между низко и высокотемпературными сверхпроводниками

2008 г ReFeAsO

Другие ВТСП

наиболее хорошо изучены Bi2Sr2CaCu2O8+x с $Tc\approx80$ K, Bi2Sr2Ca2Cu3O10+x с $Tc\approx110$ K, TI2Ba2Ca2Cu3O10+x с $Tc\approx125$ K, $ReBa2Cu3O7-\delta$ с $Tc\approx90$ K при $\delta=0$ (Re- редкоземельный элемент, кроме Ce). Рекордная на сегодняшний день критическая температура составляет около 160 K в системе Hg-Ba-Ca-Cu-O (правда, при очень сильном давлении).

Электрическая проводимость подавляющего большинства ВТСП носит дырочный характер (проводимость р-типа), Исключение ВТСП n-типа *Nd2-x CexCuO4-x* с Tc≈20 К при x = 0.15. Критическая температура большинства ВТСП очень чувствительна к отклонению их химического состава от «идеального» (стехиометрического).

Критическая температура ВТСП очень быстро падает при частичном замещении атомов меди в слоях *CuO2* на атомы никеля, цинка, кобальта, железа

Величина Тс быстро падает с ростом дозы облучения Наиболее перспективными с целью получения ВТСП оказались системы: La–Ba–Cu–O, Bi–Ca–Sr–Cu–O, Tl–Ca–Sr–Cu–O, Y–Ba–Cu–O.

Разные механизмы сверхпроводимости

три типа металлооксидов, для которых предполагаются различные механизмы сверхпроводимости:

оксиды *Ba0.6K0.4BiO3* (Tc 30K) и *BaPb0.6Bi0.25O3* (Tc 12K), а также родственные им, со структурой перовскита и очень низкой плотностью свободных носителей заряда

Второй тип включает La2-xSrxCuO4 (Tc 37 K), Bi2Sr2CuO6 (Tc 22 K) и Tl2Ba2CuO6 (Tc 80 K). Это слоистые оксиды, структуры которых содержат удаленные друг от друга плоскости CuO2, проявляют квазидвумерную сверхпроводимость. Ее обычно связывают с особыми электронными (и магнитными) свойствами "изолированной" плоскости CuO2

К третьему типу можно отнести оксиды YBa2Cu3O7, Bi2Sr2Can-1CunOx, Tl2Ba2Can-1CunOx (n=2,3) с Тс выше 80 К, в которых соседствуют две или более плоскости CuO2, разделенные не содержащими кислород прослойками из ионов Y+3 или Ca+2.

Синтез

осуществляют в твердой фазе спеканием брикетированной смеси оксидов иттрия и меди с карбонатом бария при температуре 920 – 950 °C и повышенном давлении кислорода с последующим дроблением и измельчением спека.

После получения соединения проводят отжиг в потоке кислорода для насыщения им кристаллов

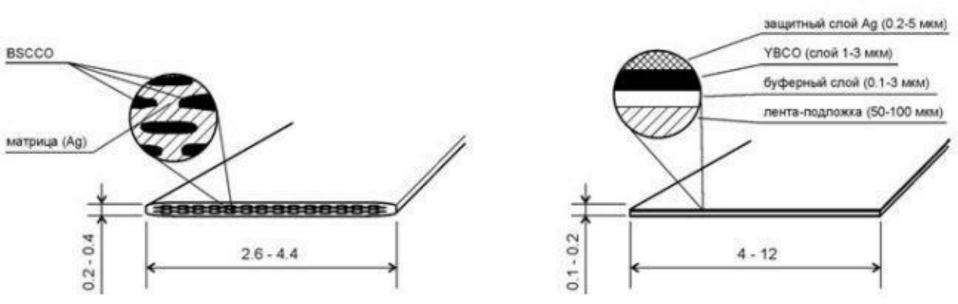
ВТСП 1 и 2 поколения

Основой для технологии ВТСП-лент после 20 лет поиска стали лишь два соединения:

(*Bi,Pb*)2*Sr*2*Ca*2*Cu*3*Ox* (сокращенно *BSCCO* или 2223, Тс 105–120К) и *YBa*2*Cu*3*O*7 (*YBCO* или 123, Тс = 90–92К).

ВТСП провод 1-го поколения

ВТСП провод 2-го поколения



ВТСП-ленты в серебряной оболочке на основе сверхпроводника *BSCCO* получили название лент первого поколения

Для создания лент 2-го поколения обычно применяют ленты-подложки (из сплавов на основе никеля), а ВТСП-жила - тонкое покрытие на поверхности ленты.

Ожидаемые практические применения

постоянные магниты с "вмороженным" магнитным потоком, поезда на магнитной подушке (проект MAGLEV), механические (ротационные) аккумуляторы энергии на основе левитирующих маховиков (flying wheels), подшипники, вращающиеся без силы трения, эффективные, экономичные моторы и сверхмощные генераторы, трансформаторы, магнитные сепараторы руды, сверхпроводящие реле, быстродействующие ограничители предельно допустимого тока, мощные бездиссипативные тоководы, активно применяющиеся в последнее время в медицине томографы, мощные магнитные системы для термоядерного синтеза, ускорителей элементарных частиц (Токамак нового поколения), магнитогидродинамические генераторы. Наиболее реальным практическим применением крупных монокристаллов могут стать подложечные материалы в технологии тонких пленок

и микроэлектронике.